PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

02-118037

(43)Date of publication of application: 02.05.1990

(51)Int.CI.

C22C 9/00

C22F 1/08 H01L 23/48

(21)Application number: 63-270836

(71)Applicant: NIPPON MINING CO LTD

(22)Date of filing:

28.10.1988

(72)Inventor: HIRANO YASUO

TOE TAMIO

(54) HIGH TENSILE AND HIGH CONDUCTIVITY COPPER ALLOY HAVING EXCELLENT ADHESION OF OXIDIZED FILM

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain the title copper alloy by specifying the surface roughness of a copper alloy having specific compsn. constituted of Mg, P and Cu.

CONSTITUTION: The high tensile and high conductivity copper alloy contains, by weight, 0.1 to 2.0% Mg and 0.001 to 0.04% P, furthermore contains as auxiliary components, at need, 0.001 to 3.0% of one or more kinds among Be, Al, Si, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Zn, Zr, Mo, Ag, Cd, Pb, In, Sn and B and the balance Cu with inevitable impurities. The alloy has \leq 0.20 μ m surface roughness in the center line average roughness (Ra) and \leq 1.5 μ m one in the maximum height (R max) and has excellent adhesion of an oxidized film and furthermore has various characteristics preferably suitable as a lead material for a semiconductor apparatus.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

◎ 公開特許公報(A) 平2-118037

⑤Int. Cl. ⁵

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)5月2日

C 22 C 9/00 C 22 F 1/08 H 01 L 23/48 8015-4K B 8015-4K V 7735-5F

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全4頁)

60発明の名称

酸化膜密着性に優れた髙力髙導電性銅合金

②特 願 昭63-270836

②出 願 昭63(1988)10月28日

@発明者 平能

康 雄

神奈川県高座郡寒川町倉見3番地 日本鉱業株式会社倉見

工場内

@発明者 東江

民 夫

神奈川県高座郡寒川町倉見3番地 日本鉱業株式会社倉見

東京都港区虎ノ門2丁目10番1号

工場内

⑪出 顋 人 日本鉱業株式会社

@代 理 人 弁理士 並川 啓志

明

細

靐

1. 発明の名称

酸化膜密着性に優れた高力高導電性組合金 2. 特許請求の範囲

(1) Mg 0.1重量%以上、2.0重量%以下、P 0.0 01重量%以上、0.04重量%以下を含み、残部Cuおよび不可避的不純物からなり、表面租さが、中心線平均租さ(Ra)で0.20μm以下、最大高さ(Rmax)で1.5μm以下であることを特徴とする酸化膜密発性に優れた高力高導電性鋼合金。

(2) Mg 0.1重最%以上、2.0重量%以下、P 0.0 01重量%以上、0.04重量%以下を含み、さらに、副成分として、Be、Ai、Si、Ti、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Zn、Zr、Mo、Ag、Cd、Pb、In、Sn、B からなる群より選択された1種又は2種以上を総量で0.001重量%以上、3.0重量%以下を含み、残部Cu および不可避的不輔物からなり、表面祖さが、中心線平均祖さ(Ra)で0.20μm以下、最大商さ(Rmax)で1.5μm以下であることを特徴とする酸化膜密発

性に優れた高力高導電性銅合金。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明はトランジスタや集積回路(IC)などの半 海体機器のリード材、コネクター、端子、リレー、 スイッチ等に用いられる、特に酸化膜密着性に優 れた筋力高導進性網合金に関するものである。

(従来の技術)

使来、半導体機器のリード材としては、無影假係数が低く、素子及びセラミックスの接着及び対発性の良好なコパール(Fe-29Ni-16Co)、42合金(Fe-42Ni)などの高ニッケル合金が好んで使われてきた。しかし、近年、半導体回路の集積度の向上に伴い消費電力の高いICが多くなってきたと、封止材料として樹脂が多く使用され、かつ素子とリードフレームの接着も改良が加えられたことにより、使用されるリード材も放熱性のよい 制場合金が使われるようになってきた。

又、従来、電気機器用ばね、計測器用ばね、ス イッチ、コネクター等に用いられるばね用材料と しては、安価な黄銅、優れたばね特性及び耐食性 を有する洋白、あるいは優れたばね特性を有する りん青銅が使用されていた。

一方、 Cu-Mg-P系網合金もまた、強度、ばね性、導電性、耐熱性、半田付け性、プレス成形性、半田の耐熱剥離性、めっき密着性等に優れた材料として半導体機器のリード材、端子、コネクター、リレー等に用いられるようになってきている。

(発明が解決しようとする問題点)

上述の半導体機器特にリード材に対する各種の要求特性に対し、従来より使用されている無酸素鋼、錫入り鋼、りん青鋼、コパール、42合金はいずれも一最一短があり、これらの特性をする合金ではない。 一方、Cu-Mg-P系合金はとかなり満足するため、Cu-Mg-P系合金やそれに若干の添加元海を加えた改良合金が開発されてきた。しかし、近年半導体に対する信頼度の要求がより厳しくなるとともに、小型化に対応した面付実装タイプが多くなってきたため、従来問題とされていなかった酸化騰密着性

すなわち、本発明は、Mg 0.1重量%以上、2.0 重量%以下、P 0.001重量%以上、0.04重量%以 下を含み、残部Cuおよび不可避的不堪物からなり、 表面相さが、中心線平均相さ(Ra)で0.20 μm以下、 最大高さ(Rmax)で1.5μm以下であることを特徴と する酸化膜密着性に優れた高力高薄電性組合金及 び Mg 0.1重量%以上、2.0重量%以下、 P 0.001 重量%以上、0.04重量%以下を含み、さらに、副 成分として、Be、Al. Si、Ti、Cr、Mn、Fe、Co、 Ni、Zn、Zr. Mo、Ag、Cd、Pb、In、Sn、B からな る群より選択された1種又は2種以上を総量で 0.001重量%以上、3.0重量%以下を含み、残部Cu および不可避的不純物からなり、表面祖さが、中 心線平均和さ(Ra)で0.20 μm以下、最大高さ(Rmax) で1.5μm以下であることを特徴とする酸化膜密存 性に優れた高力高導電性倒合金を提供しようとす るものである.

(発明の具体的説明)

以下に、本発明合金を構成する合金成分の限定理由を説明する。

が非常に重要な特性項目となってきた。

すなわち、リードフレームはパッケージングの 過程で熱が加わるため、酸化膜が必ず生成される。 樹脂等で封止された場合、樹脂と酸化膜、酸化膜 と母材との密着強度を比べると、酸化膜と母材の 密着強度が一般に低い。この場合、酸化膜と母材 との間に剥離が生じることがあり、そこから水分 等が入り、ICの信頼性を薪しく低下させてしま う。従って、酸化膜密着性はリードフレーム材等 に用いられる高力高導電性組合金として最も重要 な特性の一つである。

このような酸化吸密者性の厳しい要求に対し、 現状の Cu-Mg-P系合金では満足することができず、酸化酸密着性を改善した高力高導電性網合金 の現出が待たれていた。

【発明の構成】

本発明はかかる点に鑑みなされたもので、特に Cu-Mg-P系合金を改良し、 半導体機器のリード 材として好適な諧特性を有する網合金を提供しよ うとするものである。

Mg 0.1重量%以上、2.0重量%以下とするのは、時効処理の際 MgはPと微細なMg-P化合物による析出硬化が期待でき、さらに、それに伴い耐熱性、めっき密着性、プレス成形性が向上するためであり、Mgの含有量が 0.1重量%未満ではそのような効果が期待できず、又 2.0重量%を超えると未析出状態で固溶したMgにより導電率が低下するためである。

P 0.001重量%以上、 0.04重量%以下とするのは、Pの含有量が0.001重量%未満ではMgとの化合物の折出は不十分で、強度の向上は期待できず、0.04重量%を超えると強度は向上するものの、酸化膜密着性が著しく劣化するためである。

さらに副成分として、Be、A1、Si、Ti、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Zn、Zr、Mo、Ag、Cd、Pb、In、Sn、B から成る群より1種又は2種以上の元素を添加するのは、これらの添加により溶電率を大きく低下させずに強度を向上させることができるためであり、添加量を総歴で0.001重量%以上、3.0重量%以下とするのは、0.001重量%未満ではそのよ

うな効果は期待できず、 3.0重量%を超えると導 電性が著しく低下するためである。

表面租さを中心線平均租さ(Ra)で0.20μm以下、 最大高さ(Rmax)で1.5μm以下とするのは、表面を 平滑にすることにより酸化膜密着性を向上させる ためである。

次に本発明を実施例により具体的に説明する。 (実施例)

第1表に示す本発明合金に係る各種成分組成のインゴットを、電気網あるいは無酸素網を原料として高周波溶解炉で、大気、又は不活性あるいは還元性雰囲気中で溶解・鋳造を行った後、850℃で1時間加熱し、熱間圧延で5mmの板とした。この厚さり、冷間圧延で厚さ0.25mmの板とし、350~600℃の温度範囲で時効処理を適宜行い供試材とした。

リード材及びばね材としての評価項目として強度、引張強さ、伸び、ばね限界値により評価した。電気伝導性(放熱性)は導電率(%IACS)によっ

行った。酸化膜が剥離し始める温度を第1表に示す。

第1表から明らかなように、本発明合金は、比較合金No12、15、16のりん背鋼系合金と比べてみると酸化膜密着性が優れていることがわかる。本発明合金No3、4は比較合金No17、18と同一組成であるが、表面狙さ、Ra、Rmaxが小さいため酸化膜密着性が優れている。また、比較合金No13は強度が低く、比較合金No14は半田の耐熱刺離性が劣っている。本発明合金は比較合金に比べ、半導体機器のリード材、また端子、コネクター用材料として、バランスのとれた良好な特性を有している。

(発明の効果)

本発明合金は酸化酸密着性が著しく改善され、 リードフレーム等に用いる高力高導電性網合金と して好適である。

以下余白

て示した。繰り返し曲げ性は曲げ R 0.25 mm の折り 曲げ治具を用い、90° 往復曲げを行い破断までの 回数を測定した。

半田付け性は、垂直式浸渍法によって、230±5 ℃の半田浴(Sn60%、Pb40%)に5秒間没渍して、 半田のぬれの状態を目視観察することにより評価 した。半田の耐熱剥離性は、上記の方法で半田付 けした試料を大気中150℃、500時間加熱後、0.25 mm R の90°曲げを行い剥離の有無を評価した。

メッキ密着性は試料に厚さ3μのAgメッキを 施し、450℃にて5分間加熱し、表面に発生する フクレの有無を目視観察することにより評価した。 プレス成形性は打ち抜き加工後のプレス破面を観 察することにより評価した。

耐然性は加熱時間 5 分における軟化温度により 評価した。

酸化酸密着性は試料を200~500℃の温度にて3分間大気中で加熱して表面に酸化膜を生成させ、 試料表面に粘着テープをはり、テープを試料から 一気にはがして酸化膜の刹離の有無により評価を

93 I &

(K	ু												くり返し曲		耐然性	21:10(1)(1)	当印の耐	めっき州	7	レス	酸化胶油	は物は対	
"	仚	1 化字成分如构					(%)	表面相さ		引引の強さ	何で	游淮冰	付性	X))	秋化松度	-paulatr		esponett.	豹性 (7)	iil i	18 14:	着性 ()基	የሊ((KPመብ)
33		Cu	Hg P その他				Ra	Resox	(kgf/mm')	(%)	(% IACS)		1	(°C)_	X	2)	(対限の信集)	ひの有無)	1	(3)	HEBE)	(kt/sm')	
۳	 	- NL		0.005	<u> </u>			0.06	0.76	52	9	71	5	4	480	良	56	無	,tee	JĄ	45	420	42
A	- ;	死	0.76					0.05	0.71	56	8	67	5	4	460	R	好	無	無	且	96	380	45
*		机		0.03				0.06			11	49	4	1	450	ほ	好	無	燻	良	41	360	48
_	-	- 22		0.005	1.0Sn.	0.03		0.12	1.24	61	13	60	5	4	480	12	好	無	無	且	\$6	400	46
死	ان .	- XI		0.02	0.05%			0.13		54	10	71	4	4	480	且	47 ·	無	庶	R	46	360	37
۱		. 72			0.010c			0.05		61	14	74	4	4	460	良	97	無	無	18	46	400	44
191	b	- %·		0.03	0.4Zn,			0.07		57	9	61	5	<u></u>	440		47	無	無	Fi	ýf	360	40
١.		- 92						0.06		68	12	68	5		180		97	無	無	13	96	380	38
^		912	0.24	0.02			-,0,05In	0.05		50	10-	66			440	l	<u> </u>	無	無	13	54	400	41
	. 9.	戏		0.008	1,0Xn,			i I		63	-::	64			460	良		焦		LE LE	96	380	38
俞	-10		0.76	0.01			.0.005Рь	0.05				61		4	440	-Â	 57-	無	無		97	380	41
_	11	戏	0.68	0.01	0.0151	, 1.0	141	0.06		58	8	. 31	5	4	400	<u> </u>	好	<u>/m</u>	無	良		280	32
	12	戏		0.06	2.05n			0.06		54	10				380	_	- <u>"'</u> 43·		無	- <u>i</u>		320	28
11:	13	戏	0.47							10	14	G8	- 3			<u> </u>	好	有		ū	_::	340	28
03	14	戏		0.03	2. Fr.		/n			44		64		-:	380				無	山山	- 9F	280	77
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	15	戏	_	0.10	1.25Sn			0.07		41	12	10 -	- : -	.4	400	庄	好	f i		- 连		260	38
兪	16	%		0.12	6.25n			0.06			14		5	4	400	良	好	有				300	48
	17	戏	1.60	0.03				0.28	2.46	. 60	. 11	49	4	4	460		好	無	無	良			
	18	νc	0.26	0.005	1.0Sn.	0.0	38	0.30	2.88	56	13	68	5	4	480	溴	好	無	無	JÈ	46	3/10	39

¥1) // 圧延方向と単行サンブル 上 圧延方向と遅角サンブル X2) 良好: 半日付後の温れ面積 95%以上

不良: 半旬付後の温れ面積 95%未満

West was a store on the

(3) 破斯術比率 = <u>破</u>斯術 返原 × 100

> 良好: 破断而比率 20%以上 不良: 破断而比率 20%未満

THIS PAGE BLANK (USPTO)